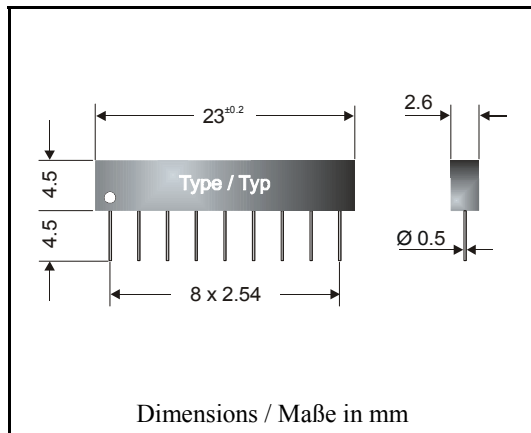


Rectifier Arrays
Gleichrichter Sätze


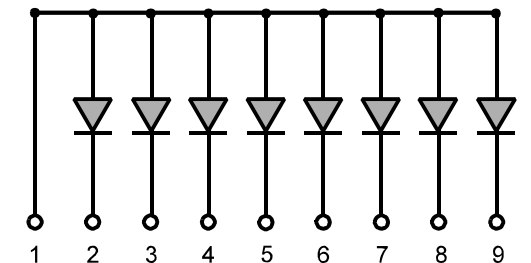
Nominal power dissipation 1.2 W
 Nenn-Verlustleistung

Repetitive peak reverse voltage 100...1000 V
 Periodische Spitzensperrspannung

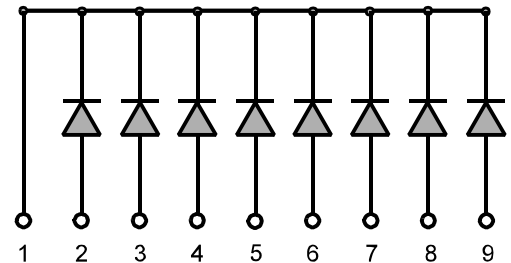
9 Pin-Plastic case 23 x 2.6 x 4.5 [mm]
 9 Pin-Kunststoffgehäuse

Weight approx. – Gewicht ca. 0.6 g

Standard packaging bulk
 Standard Lieferform lose im Karton



"DA 811 A...8110 A": com. anodes / gem. Anoden



"DA 811 K...8110 K": com. cathodes / gem. Kathoden

Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
DA 811 A/K	100	120
DA 814 A/K	400	480
DA 8110 A/K	1000	1200

Max. average forward rectified current, R-load,
 for one diode operation only
 per diode for simultaneous operation

$T_A = 25^\circ\text{C}$

I_{FAV} 600 mA ¹⁾
 I_{FAV} 150 mA ¹⁾

Dauergrenzstrom in Einwertschaltung mit R-Last,
 für eine einzelne Diode
 pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb

$T_U = 25^\circ\text{C}$

I_{FAV} 600 mA ¹⁾
 I_{FAV} 150 mA ¹⁾

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave
 Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen

$T_A = 25^\circ\text{C}$

I_{FSM} 30 A

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
 Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten

Max. power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	1.2 W ¹⁾
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	– 50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	– 50...+150°C

Characteristics	Kennwerte			
Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1\text{ A}$	V_F	< 1.1 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{\text{RRM}}$ $V_R = V_{\text{RRM}}$	I_R I_R	< 10 µA < 90 µA
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 85 K/W ¹⁾

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten